性能特点

- 频率范围：24.5GHz～26GHz
- 功率增益：25dB
- P1dB：23dBm
- 功率附加效率：35%
- +5V @ 115mA(静态)
- 芯片尺寸：1.85mm×1.20mm×0.08mm

产品简介

NC11263C-2526 是一种 GaAs MMIC 功率放大器芯片，频率范围覆盖 24.5GHz～26GHz，P1dB 大于 23dBm，功率增益大于 25dB，功率附加效率大于 35%。

电参数（TA=+25℃）

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	24.5-26			GHz
饱和输出功率	24			dBm
P1dB	23			dBm
功率增益	25			dB
增益平坦度			±0.5	dB
功率附加效率	35			%
输入驻波			2.5	-
工作电流			160	mA

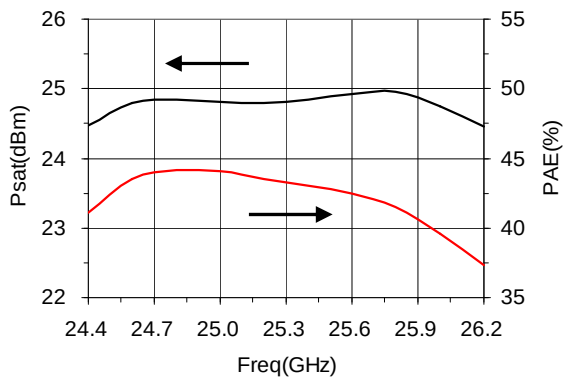
注：1）芯片均经过在片 100%直流测试。
2）测试条件：Vd=+5V，Vg=-0.7V，连续波。

使用限制参数

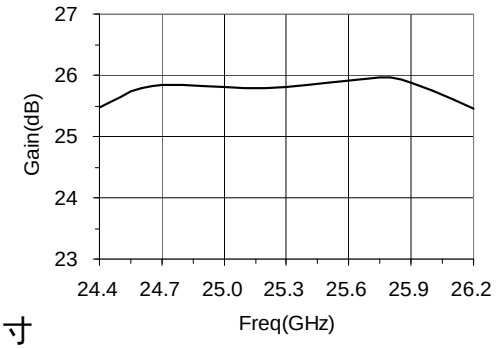
参数	数值
漏源正向偏压	8V
栅源负偏压	-2V
输入连续波功率	+3dBm
沟道温度	175℃
贮存温度	-65℃～150℃

典型曲线

饱和输出功率/功率附加效率 vs.频率

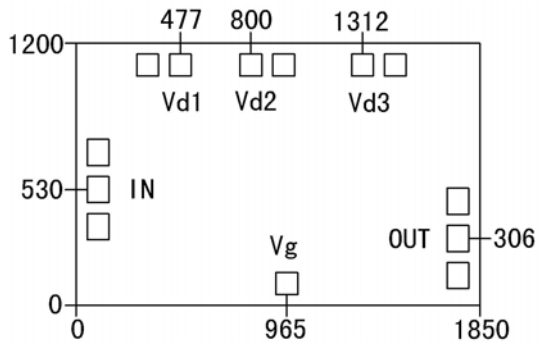


功率增益 vs.频率



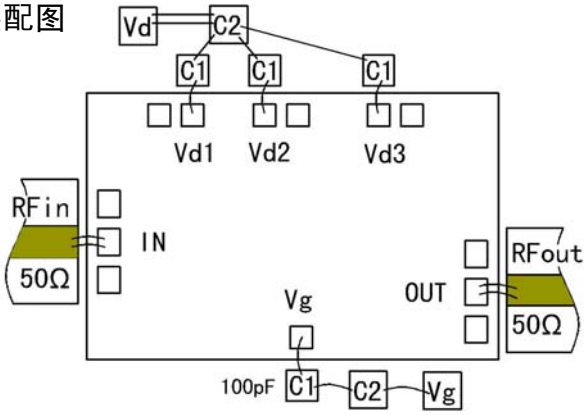
外形尺寸

NC11263C-2526 的外形尺寸



注：图中单位均为微米，输入输出压点 100×120μm²，
DC 压点 100×100μm²，外形尺寸公差：±50μm。

建议装配图



注：外围电容的容值为 C1=100pF,C2=1000pF。

注意事项：

1) 单片电路需贮存在干燥洁净的 N_2 环境中；
2) GaAs 材料很脆，使用时必须小心，以免损伤芯片；
3) 载体的导热性能越高越好，装配时芯片与载体之间要避免孔洞，利于功率单片的散热；
4) 载体的热膨胀系数应与 GaAs 匹配,GaAs 的线热膨胀系数为 6.86×10^{-6}/℃，建议衬底材料选用 CuW 或 CuMo；
5) 建议用金锡焊料烧结，Au:Sn=80%:20%,烧结温度不超过 300℃，时间不长于 30 秒；
6) 输入输出有隔直电容；
7) 上电时，先加栅压后加漏压；去电时，先降漏压后降栅压；
8) 输入输出使用 2 条（直径 25μm～30μm 金丝）键合线，键合台底盘温度不超过 250℃，键合时间尽量短；
9) 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯，烧结、键合台接地良好；
10) 有问题请与供货商联系。